

1S1585 ~ 1S1588

シリコンエビタキシャルプレーナ形ダイオード

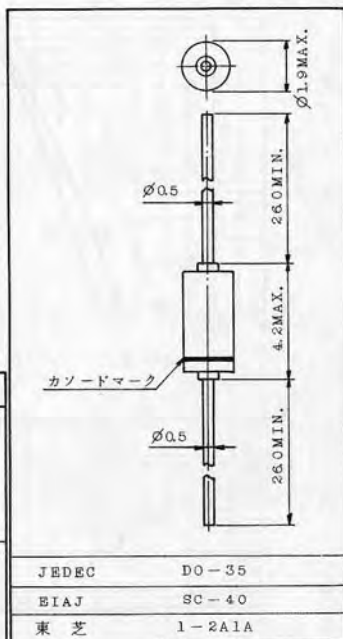
参考資料

単位：mm

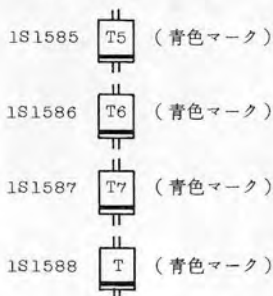
- 通信，制御，計測機器用
- 超高速スイッチング用
- 外形が小さい。 : DO-7 の約 1/4 の体積
- 許容電力損失が大きい。 : $P=300\text{mW}$ (最大)
- 順方向特性が良い。 : $V_F=1.0\text{V}$ (最大)
($I_F=100\text{mA}$)(1S1585)
- 逆回復時間が小さい。 : $t_{rr}=2\text{ns}$ (最大)
- 端子間容量が小さい。 : $C_T=2\text{pF}$ (最大)

最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	記号	定 格	単 位
せん 頭 逆 電 圧	1S1585	V_{RM}	90	V
	1S1586		55	
	1S1587		55	
	1S1588		35	
逆 電 圧	1S1585	V_R	80	V
	1S1586		50	
	1S1587		50	
	1S1588		30	
せん 頭 順 電 流	1S1585	I_{FM}	480	mA
	1S1586		400	
	1S1587		400	
	1S1588		360	
平 均 整 流 電 流	1S1585	I_O	150	mA
	1S1586		130	
	1S1587		130	
	1S1588		120	
サージ電流 (1sec)	1S1585	I_{surge}	700	mA
	1S1586		600	
	1S1587		600	
	1S1588		600	
許 容 損 失	P		300	mW
接 合 温 度	T_j		175	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}		-65 ~ 175	$^\circ\text{C}$



注：現品には次の通り形名表示されております。

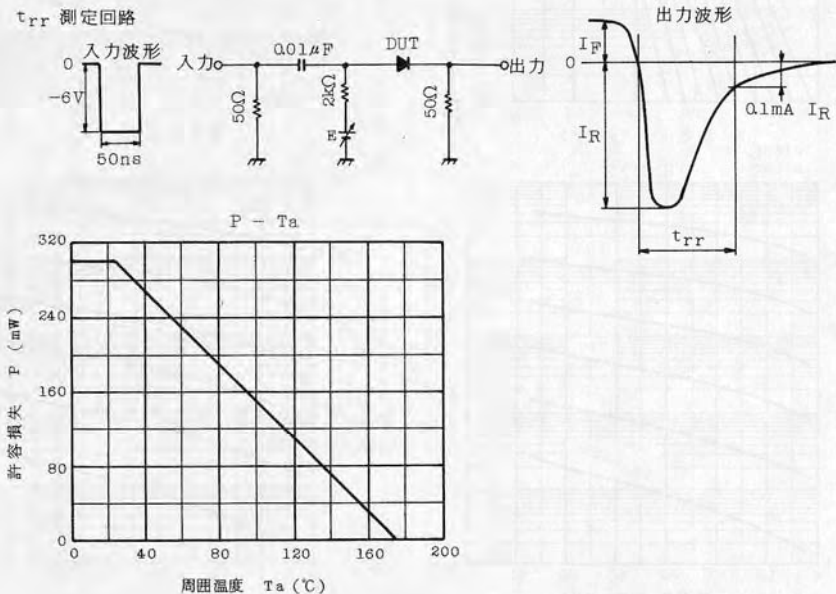


1S1585 ~ 1S1588

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
順電圧	1S1585	$I_F = 100\text{mA}$	-	-	1.0	V
	1S1586				1.2	
	1S1587				1.3	
	1S1588					
逆電流	1S1585	$V_R = 80\text{V}$	-	-	0.5	μA
	1S1586	$V_R = 50\text{V}$				
	1S1587	$V_R = 30\text{V}$				
	1S1588					
端子間容量	1S1585	$V_R = 0, f = 1\text{MHz}$	-	-	2	pF
	1S1586					
	1S1587					
	1S1588				3	
逆回復時間	1S1585	$V_R = 6\text{V}, I_F = 10\text{mA}$ $R_L = 100\Omega$ (図1)	-	-	2	ns
	1S1586					
	1S1587					
	1S1588				4	

図1 t_{rr} 測定回路



1S1585 ~ 1S1588

